

度 (junction depth) 或曲率半徑 (radius of curvature) x_j 愈小，則界面曲率效應愈顯著 (即界面崩潰電壓愈小)，尤其是對低摻雜濃度的界面更加明顯。

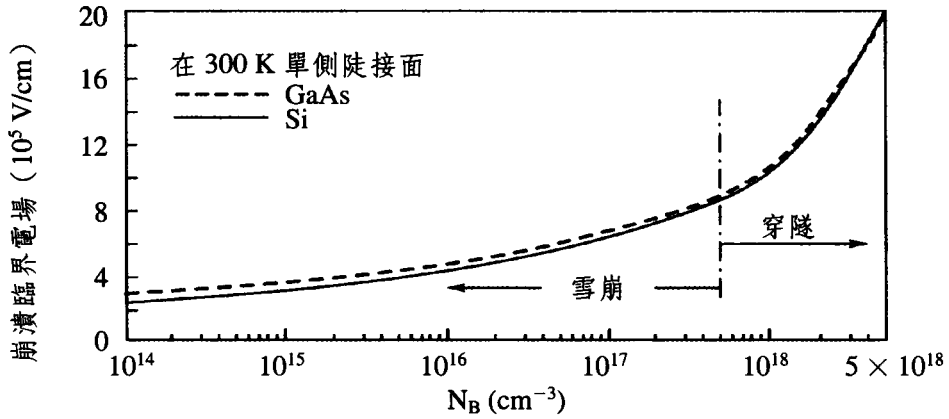


圖 2-24 在單側陡界面中，崩潰臨界電場和雜質摻雜濃度 N_B 的關係圖 (取自 Sze [2])。

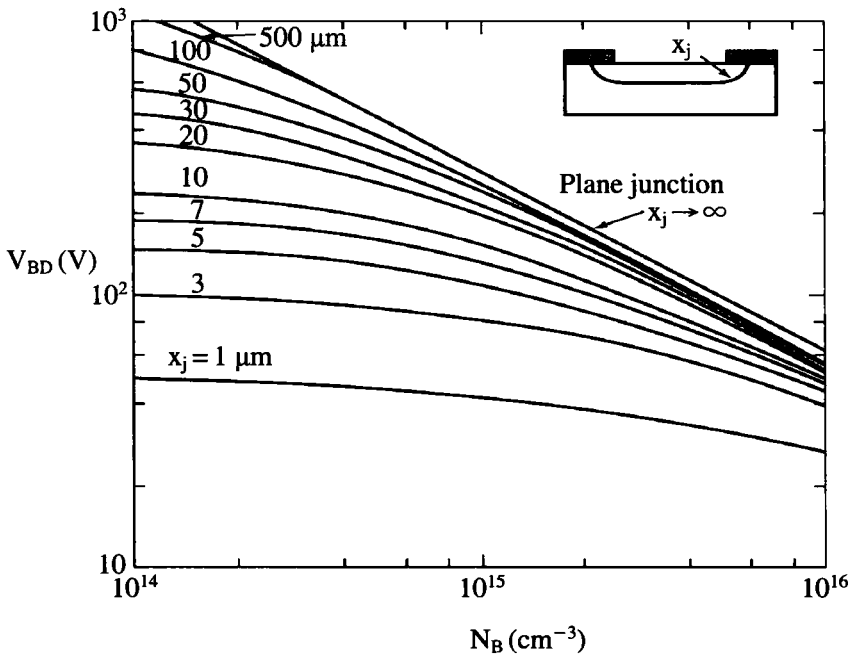


圖 2-25 單側陡界面之摻質側圖，其崩潰電壓 V_{BD} 對雜質濃度 N_B 和界面深度 x_j 的關係 (取自 Muller & Kamins[4])。